

Код ОКП
63 4132 465 1

Транзисторы:
 KE738A-5 (An100IGB17) (кристалл);
 KE738A-5 (An100IGB17) (неразделенные)
 (Проставляется знак «\» в поле перед наименованием конкретно поставляемого транзистора)

Э Т И К Е Т К А ПАКД.432147.100ЭТ

Ключи высоковольтные полупроводниковые KE738A-5 (An100IGB17)

Ключи высоковольтные полупроводниковые – бескорпусные кремниевые биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ) типа KE738A-5 (An100IGB17) (далее - транзисторы) в конструктивном исполнении 5 с контактными площадками без кристаллодержателя (подложки), без выводов (кристалл), а также на общей пластине (неразделенные) предназначены для применения в высоковольтных силовых модулях для коммутации напряжений до 1700 В.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры транзисторов приведены на чертеже транзистора (кристалла) ПАКД.757644.454.

На упаковочной бандероли указывается:

- обозначение транзистора – KE738A-5 (An100IGB17) (кристалл) или KE738A-5 (An100IGB17) (неразделенные);
- номер технических условий – АДКБ.432140.501ТУ;
- количество транзисторов (кристаллов) или количество пластин и годных транзисторов на них;
- знак чувствительности к статическому электричеству в виде равностороннего треугольника Δ с вершиной, направленной вверх.

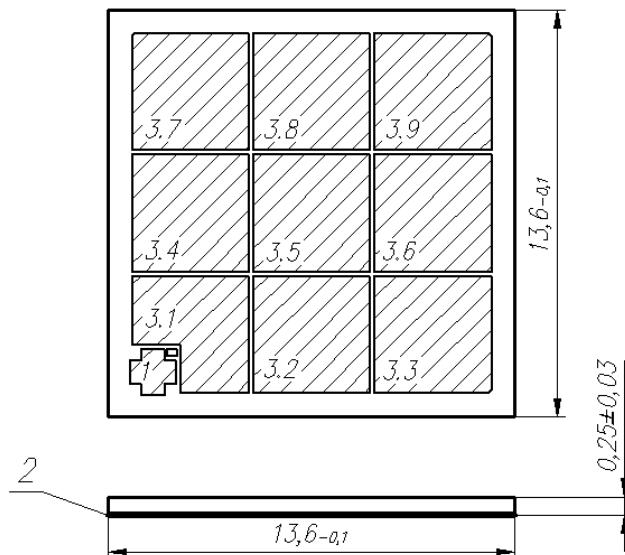


Рисунок 1 – Общий вид транзисторов

Нумерация, обозначение и назначение контактных площадок (КП) транзисторов приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Нумерация, обозначение и назначение контактных площадок транзисторов

Номер КП кристалла	Обозначение КП	Назначение КП
1	3	Затвор транзистора
2	К	Коллектор транзистора (обратная сторона кристалла)
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9	Э	Эмиттер транзистора

Масса транзистора – не более 0,3 г.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Значения электрических параметров транзисторов при приемке и поставке и транзисторов в условном корпусе

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Темпера- тура корпуса, °C
		не менее	не более	
1 Напряжение пробоя коллектор-эмиттер, В, (U _{3Э} = 0 В, I _K = 1 мА)	U _{KЭ} проб.	1 700 ^{1),2)}	–	25±10
		1 360 ²⁾	–	–60
		1 700 ²⁾	–	125
2 Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, (U _{KЭ} = 1 700 В, U _{3Э} = 0 В); (U _{KЭ} = 1 360 В, U _{3Э} = 0 В); (U _{KЭ} = 1 700 В, U _{3Э} = 0 В)	I _{KЭК}	–	0,1 ^{1); 10²⁾}	25±10
		–	30 ²⁾	–60
		–	30 ²⁾	125
3 Ток утечки затвора, нА, (U _{KЭ} = 0 В, U _{3Э} = 30 В); (U _{KЭ} = 0 В, U _{3Э} = –30 В)	I _{3. ут}	–	100 ^{1),2)}	25±10
		–	500 ²⁾	–60
		–	500 ²⁾	125
		–100 ^{1),2)}	–	25±10
		–500 ²⁾	–	–60
		–500 ²⁾	–	125
4 Пороговое напряжение, В, (U _{3Э} = U _{KЭ} , I _K = 1 мА)	U _{3Э} пор	4,0 ¹⁾	7,0 ¹⁾	25±10
		3,0 ²⁾	8,0 ²⁾	
		3,0 ²⁾	10,0 ²⁾	
		1,0 ²⁾	8,0 ²⁾	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
5 Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, ($U_{3\beta} = 15$ В, $I_K = 50$ А) ¹⁾ ;	$U_{K\beta}$ нас	—	3,0 ¹⁾	25 ± 10
($U_{3\beta} = 15$ В, $I_K = 100$ А) ²⁾		—	3,5 ²⁾	
		—	4,0 ²⁾	-60
		—	7,0 ²⁾	125

¹⁾ Для транзисторов.²⁾ Для транзисторов в условном корпусе.

1.2 Электрические параметры транзисторов в условном корпусе, изменяющиеся в течение наработки приведены в таблице 3. Остальные параметры соответствуют нормам, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 3 – Значения электрических параметров транзисторов в условном корпусе, изменяющиеся в течение наработки

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Темпе- ратура корпуса, °C
		не менее	не более	
1 Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, ($U_{K\beta} = 1700$ В, $U_{3\beta} = 0$ В)	$I_{K\beta K}$	—	1,0	25 ± 10

Т а б л и ц а 4 – Пределы допустимые электрические режимы эксплуатации транзисторов в условном корпусе в диапазоне рабочих температур среды (корпуса)

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра	Номер пунктов примечания
1 Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В, ($U_{3\beta} = 0$ В)	$U_{K\beta}$ max	1 700	1
2 Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-эмиттер, В	$U_{3\beta}$ max	± 30	
3 Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	I_K max	100	2
4 Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А, ($\tau_i \leq 300$ мкс и $Q \geq 100$)	I_K (и) max	200	2
5 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт	P_{max}	350	
6 Максимально допустимая температура перехода, °C	$T_{PER. max}$	150	—

П р и м е ч а н и я:

1 В диапазоне температур корпуса от плюс 125 до минус 40 °C. При снижении температуры корпуса от минус 40 до минус 60 °C напряжение $U_{K\beta}$ max линейно снижается до $0,8 \cdot U_{K\beta}$ max.

2 При температуре корпуса плюс 25 °C.

1.3 Содержание драгоценных материалов в 1 000 шт. приборов

Золото _____ г;

Серебро _____ г.

1.4 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Интенсивность отказов λ_3 в течение наработки t_h – не более 10^{-6} 1/ч.2.2 Значение наработки t_h – не менее 25 000 ч.

2.3 Срок сохраняемости приборов в упаковке изготовителя в отапливаемых складских помещениях – 40 суток.

2.3.1 В пределах срока сохраняемости допускается нахождение транзисторов после их изъятия потребителем из упаковки изготовителя в период производства ГС (до герметизации) – 20 сут. в условиях производства, аттестованного специальной комиссией на полное соответствие ОСТ 11.14.3302 при соблюдении указаний по применению.

2.3.2 В пределах срока сохраняемости допускается нахождение транзисторов после их изъятия из упаковки изготовителя в период производства ГС (до герметизации) – 10 суток в условиях, соответствующих требованиям, предъявляемым к производству ГС и указаниям по применению.

2.4 Гамма-процентный срок сохраняемости транзисторов в составе ГС при хранении в отапливаемых и вентилируемых складских помещениях, а также в составе ГС, вмонтированных в аппаратуру, или в комплекте ЗИП – 10 лет при заданной вероятности $\gamma = 95$ %.

2.5 Срок сохраняемости транзисторов в упаковке изготовителя исчисляется с даты их отгрузки. Срок сохраняемости транзисторов в составе ГС исчисляется со дня их изготовления.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества поставляемых транзисторов требованиям АДКБ.432140.501ТУ и ОСТ В 11 336.925 при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных настоящей ЭТ и АДКБ.432140.501ТУ.

Изготовитель гарантирует работоспособность транзисторов в составе ГС при условии выполнения указаний АДКБ.432140.501ТУ.

3.2 Гарантийная наработка транзисторов в составе ГС равна 25 000 ч со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантированного срока хранения в составе ГС.

3.3 Гарантийный срок хранения транзисторов в упаковке изготовителя в отапливаемых складских помещениях – 40 суток.

Гарантийный срок хранения транзисторов в составе ГС равен гамма-процентному сроку сохраняемости приборов в составе ГС при хранении в отапливаемых и вентилируемых помещениях, а также, вмонтированных в аппаратуру, или в комплекте ЗИП – 10 лет при заданной вероятности $\gamma = 95\%$.

Гарантийный срок хранения приборов до герметизации их в составе ГС исчисляется с даты их отгрузки.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы KE738A-5 соответствуют техническим условиям АДКБ.432140.501ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)

подпись лица, ответственного за приемку
(помещают в случае проставки общего штампа СКК)

место для штампа СКК
(индивидуальный
или общий)

«Перепроверка произведена _____»
дата

Приняты по _____ от _____
указывают документ о приемке (извещение, акт и др.)

подпись лица, ответственного за приемку
(помещают в случае проставки общего штампа СКК)

место для штампа СКК
(индивидуальный
или общий)

Цена договорная

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Указания по применению и эксплуатации транзисторов – по ОСТ 11 336.925 и ОСТ 11.336.907.0 с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем разделе.

5.1.1 Основное назначение транзисторов – предназначены для использования в качестве высоковольтных полупроводниковых ключей.

5.2 Транзисторы чувствительны к воздействию СЭ – допустимое значение потенциала СЭ не более 200 В.

5.3 Производство ГС (микросборок) – по ОСТ 11 0272 с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем разделе.

5.3.1 Особенности конструкции транзисторов:

Рабочая поверхность транзисторов (кроме линии реза и контактных площадок) защищена полиимидом.

На лицевой стороне кристалла – алюминиевая металлизация и сформированы контактные площадки «затвора» и «эмиттера» толщиной не менее 4 мкм.

На обратной стороне кристалла – металлизация Ti-Ni-Ag толщиной не менее 1 мкм и по всей площади сформирована контактная площадка «коллектиора».

5.3.2 Кристалл рекомендуется крепить на монтажную площадку основания металлокерамического корпуса или металлическую подложку методом пайки в среде водорода, формир-газа или в вакууме с воздействием температуры не выше плюс 380 °C в течение не более 5 мин.

Припой должен покрывать всю площадь нижней части кристалла равномерно без пор и раковин.

5.3.3 Разварку межсоединений от контактной площадки кристалла до вывода корпуса или подложки рекомендуется выполнять методом ультразвуковой сварки алюминиевой проволокой:

- «затвор» – диаметр до 500 мкм,
- «эмиттер» – диаметр до 500 мкм.

Длина, диаметр и количество проводников для «эмиттерной» площадки выбирается при соблюдении требований ОСТ 11 336.905 и АДКБ.432140.501ТУ.

5.4 Допускается параллельное включение транзисторов. Для исключения генерации рекомендуется в цепи затворов транзисторов включать резисторы номиналом от 10 до 100 Ом.

С целью обеспечения равномерного прогрева линейки транзисторов необходимо устанавливать их на общий теплоотвод и, по возможности, ближе друг к другу.

5.5 При использовании двух источников напряжения питания транзисторов:

- при включении сначала подают напряжение на вывод затвора, а затем на вывод коллектора, или одновременно;
- при выключении сначала снимают напряжение с вывода коллектора, а затем с вывода затвора, или одновременно.

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Значения электрических параметров транзисторов в условном корпусе при температуре корпуса $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 – Значения электрических параметров транзисторов в условном корпусе при температуре корпуса $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра		
		мини- мальное	типовое	макси- мальное
Напряжение пробоя коллектор-эмиттер, В, $(U_{3\beta} = 0 \text{ В}, I_K = 1 \text{ мА})$	$U_{K\beta.\text{проб.}}$	1 700	1 755	–
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, $(U_{K\beta} = 1 700 \text{ В}, U_{3\beta} = 0 \text{ В})$	$I_{K\beta\text{К}}$	–	0,001	0,1
Ток утечки затвора, нА, $(U_{K\beta} = 0 \text{ В}, U_{3\beta} = \pm 30 \text{ В})$	$I_{3\beta\text{ут}}$	–100	± 80	100
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, $(I_K = 100 \text{ А}, U_{3\beta} = 15 \text{ В})$	$U_{K\beta.\text{нас}}$	–	2,4	3,5
Пороговое напряжение, В, $(U_{3\beta} = U_{K\beta}, I_K = 1 \text{ мА})$	$U_{3\beta.\text{пор}}$	4,0	5,5	7,0
Время задержки включения, нс, $(U_{K\beta} = 850 \text{ В}, U_{3\beta} = \pm 15 \text{ В}, I_K = 100 \text{ А},$ $R_{31} = 10 \text{ Ом})$	$t_{3\beta.\text{вкл}}$	–	180	200
Время нарастания, нс, $(U_{K\beta} = 850 \text{ В}, U_{3\beta} = \pm 15 \text{ В}, I_K = 100 \text{ А},$ $R_{31} = 10 \text{ Ом})$	$t_{\text{нр}}$	–	49	60
Время задержки выключения, нс, $(U_{K\beta} = 850 \text{ В}, U_{3\beta} = \pm 15 \text{ В}, I_K = 100 \text{ А},$ $R_{31} = 10 \text{ Ом})$	$t_{3\beta.\text{выкл}}$	–	380	400
Время спада, нс, $(U_{K\beta} = 850 \text{ В}, U_{3\beta} = \pm 15 \text{ В}, I_K = 100 \text{ А},$ $R_{31} = 10 \text{ Ом})$	$t_{\text{сп}}$	–	680	700
Входная емкость, пФ, $(U_{K\beta} = 25 \text{ В}, U_{3\beta} = 0 \text{ В}, f = 1 \text{ МГц})$	C_{11}	–	5 500	6 000
Проходная емкость, пФ, $(U_{K\beta} = 25 \text{ В}, U_{3\beta} = 0 \text{ В}, f = 1 \text{ МГц})$	C_{12}	–	380	–
Выходная емкость, пФ, $(U_{K\beta} = 25 \text{ В}, U_{3\beta} = 0 \text{ В}, f = 1 \text{ МГц})$	C_{22}	–	720	–
Встроенный резистор в цепи затвора, Ом $(I_3 = 1 \text{ мА})$	R_3	–	5	–

Примечание:
 R_{31} – резистор в цепи затвора.